



# NSG2024 250V 4A 单相高低侧功率 MOSFET/IGBT 驱动芯片

## 1 产品特性

- 自举工作的浮地通道
  - 最高工作电压为+250V
  - 兼容 3.3V, 5V 和 15V 输入逻辑
  - dVs/dt 耐受能力可达±50 V/ns
  - Vs 负偏压能力达-9V
  - 栅极驱动电压从 10 V 到 20V
  - 防直通死区逻辑
    - 死区时间设定 250ns
  - 芯片传输延时特性
    - 开通/关断传输延时 Ton/Toff =150ns/150ns
    - 延迟匹配时间 50ns
  - 宽温度范围-40°C ~125°C
  - 输出级拉电流/灌电流能力 4A/4A
  - 集成自举二极管
  - 符合 RoSH 标准
- SOP8 (S)

## 2 应用范围

- 电机控制
- 空调/洗衣机
- 通用逆变器
- 微型逆变器驱动

## 3 产品概述

NSG2024 是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。NSG2024 采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成，逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平，输出具有大电流脉冲能力和防直通的死区逻辑。NSG2024 集成有自举二极管，对高侧进行充电，简化了芯片外围电路。NSG2024 其浮动通道可用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET，浮地通道最高工作电压可达 250V。NSG2024 采用 SOP8 封装，可以在 -40°C 至 125°C 温度范围内工作。

### 器件信息

零件号	封装	封装尺寸（标称值）
NSG2024	SOP8	4.9mm*3.9mm

### 简化示意图

